PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-133761

(43) Date of publication of application: 18.05.2001

(51)Int.CI.

G02F 1/1333 G09F 9/30 H05B 33/02 H05B 33/14

(21)Application number: 11-313337

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

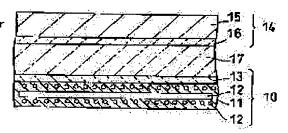
04.11.1999

(72)Inventor: IKEDA MITSUSHI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ORGANIC LED DEVICE

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device and an organic LED device in which thermal deformation and a deformation by moisture absorption of a plastic substrate is decreased, which has high picture quality and which can be made light in weight.

SOLUTION: As for the substrate 10 of the liquid crystal display device or the organic LED device of this invention, the following substrate is used. The substrate is prepared by embedding linear or strip fibers 12 separated from each other in a plastic layer 11 and forming an electrode 18 on one surface of the plastic layer 11. Or, the substrate is prepared by embedding carbon fibers 12 in the plastic layer 11 and forming an electrode 13 on one surface of the plastic layer 11.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.09.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

盐 华 噩 4 3 (19) 日本国格許庁 (JP)

퐳 4

特開2001-133761 (11)特許出願公頭番号 €

(51) Int CL.		推 別配号	1 <u>e</u>			デーマコート"(参考)
G02F	1/1333	500	GOZF	1/1333	500	2H090
G09F		310	G09F	9/30	310	3K007
H05B	33/05		H05B	33/02		5C094
	33/14			33/14	¥	

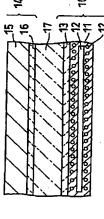
特闘平11-313837 (71)出闘人 000003078	株式は1年11月4日(1999, 11.4) 神奈川県川崎市幸区現川町72番地 (72)発明者 地田 光志 神奈川県横浜市磯子町33番地 神奈川県横浜市磯子町33番地	式会社東芝生産技術センター内 (74)代理人 100081732 弁理士 大胡 典夫 (外1名)	
(21) 出願番号 特	(22) 出館日 平5		,

被晶表示索子及C有機LED案子 (54) [発野の名称]

(57) [要約

【課題】 本発明は、プラスチック基板の熱変形及び吸 **遠による変形を少なくし、髙い画質を有し、軽畳化が可** 能な液晶表示素子及び有機LED素子を提供することを

ED繋子の基板10として、内部に線状あるいは帯状の 繊維12が互いに隔てられてプラスチック層 1/1 に埋め 込まれており前配プラスチック層 1.1の一方の面に電極 13が形成されてなるもの、あるいは内部にカーボン機 雄12がプラスチック層11に埋め込まれており前配プ ラスチック層11の一方の面に鶴極13が形成されてな 【解決手段】 本発明は、液晶表示素子あるいは有機し るものをものを用いることを特徴とする。



9 **B. 林 区 い 根 く** (43)公開日 平成13年5月18日(2001.5.18) 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全10 頁) (P2001-133761A)

[特許請求の節用]

【請求項1】内部に線状あるいは帯状の繊維が互いに隔 の面に電極が形成されてなる第1基板と、前配第1基板 の電極が形成された面と対向して散けられ前配第1 基板 との対向面に透明電極が形成された透明層を備える第2 基板と、前配第1基板と第2基板との間に設けられた液 てられて埋め込まれたプラスチック層の少なくとも一方 聶層とを少なくとも備えることを特徴とする液晶表示素

【請求項2】内部にカーボン繊維が埋め込まれたプラス チック層の少なくとも一方の面に電極が形成されてなる 第1基板と、前記第1基板の電極が形成された面と対向 して設けられ前配第1基板との対向面に透明電極が形成 された透明層を備える第2基板と、前配第1基板と第2 基板との間に設けられた液晶層とを少なくとも備えるこ とを特徴とする液晶表示案子。

一対の電極層間に狭持された有機発光層とを備える有機 の面に一対の電極層が形成されてなる第1基板と、前配 【簡求項3】内部に線状あるいは帯状の繊維が互いに隔 てられて埋め込まれたプラスチック層の少なくとも一方 LED案子

チック層の少なくとも一方の面に一対の電極圏が形成さ 【請求項4】内部にカーボン機維が埋め込まれたプラス **れてなる第1基板と、前配一対の電極層間に狭持された** 有機発光層とを備える有機LED寮子。 |発明の詳細な説明|

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示素子及び f機LED素子に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、衛星通信や移動通信技術の進展に であることが求められており液晶表示業子が最も多用さ れている。特に薄型で軽量に作製することができ、かつ 携帯俼報端末機器の多くに搭載される表示装置には薄型 挙明な画像の得られるTFT駆動パネルが用いられるこ 半い、小型携帯情報端末機器の需要が高まりつつもる。 とが主流となりつつある。

ことにより軽量化が可能になる。しかし、プラスチック 【0003】ところで、この種の液晶装示繋子を携帯情 **報端末機器に用いる場合、基板にプラスチックを用いる** と、吸煙による変形があるために、TFTアレイを作成 するためのマスク合わせが困難であり、ガラス基板を用 いた場合と比較して精度高く液晶表示素子を得ることが 基板では熱膨張係数が大きく熱による変形があること 困難であった。

る反射型液晶表示案子用のプラスチック基板が開示され ド等からなる樹脂などのフィラメントによりなることが **蜥脂を含浸させて硬化させた繊維布を含む積層層からな** ており、特に前配機維布は、ガラスや、芳香族ポリアミ 【0004】一方、梅開平11-2812号公報には、

記載されている。また前配基板は水蒸気パリア性、耐熱 性、剛性等に優れていることが配載されている。

[0005]しかしながら、上配の如くの樹脂を含浸さ せた繊維布を含む積層層を液晶表示案子の基板として用 いるとその繊維布の繊維の織目や重なり目に起因した微 小な凹凸が基板表面に生じ、画質の劣化の原因となって 【0006】また、上配の如くのガラスや樹脂などの観 形を抑える効果が小さく、ガラス基板を用いた場合と比 して用いても、それらの材料からなる機雄では基板の変 **餃してマスク合わせが困難であり、精度高く液晶表示素** 維からなる繊維布を含む積層層を液晶表示素子の基板と 子を得ることは依然として困難であった。

目に起因した微小な凹凸が生じ、画質の劣化の原因とな 液晶表示素子の場合と同様に基板表面にその機構布の機 【0007】また、同公報には前配の如くの、樹脂を含 没させて硬化させた繊維布を含む積層層からなるプラス **【0008】しかじながら、EL寮子に前樹脂を含覆さ** チック基板をエレクトロルミネッセンスを用いた喪示線 子(EL繋子)にも適用できることが配載されている。 せた繊維布を含む積層層を基板として適用した場合も、 ってしまう。

であり、精度高くEL繋子や液晶表示繋子を得ることは ガラス基板を用いた場合と比較してマスク合わせが困難 [0009]また、基板の変形を抑える効果が小さく、 困難である。

[0010]

形成する際にマスク合わせが困難であるという問題点が 従来のプラスチック基板を用いた液晶表示繋子は、熱や 吸慮により基板の変形が生じやすく、TFTアレイ等を 【発明が解決しようとする課題】以上群述したごとく、 かった。

【0011】また、画質の高い液晶表示繋子を得ること は困難であるという問題点があった。

従来のプラスチック基板を用いた場合熱や吸避により基 坂の変形が生じ、TFTアレイ等を形成する際にマスク 【0012】また、有機LED素子においても同様に、 合わせが困難であるという問題点があった。

【0013】また、画質の高い有機LED素子を得るこ とは困難であるという問題点があった。

吸湿による変形を少なくし、高い画質を有し、マスク合 【0014】本発明は、プラスチック基板の熱変形及び **わせが容易で精度高く製造することを可能にした、軽量** な液晶表示案子及び有機LED案子を提供することを目

[0015]

込まれたプラスチック層の少なくとも一方の面に電極が 形成されてなる第1基板と、前配第1基板の電極が形成 内部に橡状あるいは帯状の機構が互いに隔てられて埋め 【課題を解決するための手段】本発明の第1の構成は、

ව

椎が埋め込まれたプラスチック層の少なくとも一方の面 に電極が形成されてなる第1基板と、前配第1基板の電 極が形成された面と対向して設けられ前配第1基板との 対向面に透明電極が形成された透明層を備える第2基板 と、前配第1基板と第2基板との間に設けられた液晶層 【0016】本発明の第2の構成は、内部にカーボン機 とを少なくとも備えることを特徴とする液晶表示案子で

【0017】本発明の第3の構成は、内部に熱状あるい は帯状の繊維が互いに隔てられて埋め込まれたプラスチ ック層の少なくとも一方の面に一対の電極層が形成され てなる第1基板と、前配一対の電極層間に狭特された有 娥発光層とを備える有機LED案子である。

に一対の電極層が形成されてなる第1基板と、前配一対 【0018】本発明の第4の構成は、内部にカーボン機 誰が埋め込まれたプラスチック層の少なくとも一方の面 の電極層間に狭持された有機発光層とを備える有機LE D紫子である。

【0019】以下に本発明の作用について説明する。

【0020】本発明の第1の構成においては、液晶表示 維が埋め込まれたプラスチック層の一方の面に鵯極が形 **栞子の一方の基板として、内部に線状あるいは帯状の機** 用により、熱変形や吸湿変形が小さくなる。また、基板 【0021】前配第1基板は、プラスチック基板や有の 軽量さという特徴を有しながら、埋め込まれた機維の作 成されてなるプラスチック基板(第1基板)を用いる。 全体としての機械的強度が高くなる。

[0022] したがって第1基板を被晶表示繋子の基板・ として用いることによりTFTアレイ等を形成する際に マスク合わせが容易になる。

[0023] さらに対向基板である第2基板としてガラ スを用いれば、熱膨張係数が近くなるために貼り合せが 容易となる。 [0024] また第1基板を液晶表示繋子の基板として 用いることにより、製造工程での基板保持、基板搬送が 容易であり製造歩留まりが向上する。

【0025】さらに第1基板においては、埋め込まれた 概雄は、趣られたり、機雄同士が直接重なったり直接交 **塾した状態ではなく、線状あるいは帯状の繊維同士が互** いに離れた状態でプラスチック層内に埋め込まれる。そ のため従来技術の如くの樹脂を含没させた繊維布を含む 積層層を基板として用いた場合において基板装面に生じ る繊維布の微目や重なり目に起因した凹凸が生じず、ま た面内の屈折率の変化も抑えられ液晶表示葉子の画質が 劣化が抑えられる。

8 [0026] 本発明の第2の構成によれば、液晶表示案

子の一方の基板として、内部にカーボン繊維という特に **乳膨張係数が小さく、剛性の高い材料からなる繊維が埋** め込まれたプラスチック層の一方の面に電極が形成され てなるプラスチック基板(第1基板)を用いる。

[0027] 前配第1基板は、プラスチック基板特有の 熱、吸湿による変形が非常に小さいため、熱変形や吸温 変形が非常に小さくなる。また、基板全体としての機械 怪畳さという特徴を有しながら、埋め込まれた繊維の 的強度が非常に高くなる。

大きいために放熱性が良い。又、カーボン繊維の剛性率 は、プラスチックの1E5kg/cm2、ガラスの6E 【0028】 ちなみに熟伝導率がガラスの約0.8Wm K, プラスチックの約0. 14W/mKに比べ600W/mKと 5 k g / c m 2、に 比べ、 5 E 6 k g / c m 2 と 大き 【0029】したがって、第1基板を液晶表示繋子の基 板として用いることによりTFTアレイ等を形成する瞭 にマスク合わせが容易になる。

【0030】さらに対向基板である第2基板としてガラ スを用いた際には、ガラスとの熟糖鏝係数が近接するた めに貼り合せが容易となる。

【0031】また第1基板を被晶表示察子の基板として 用いることにより、製造工程での基板保持、基板搬送が 容易であり製造歩留まりが向上する。

【0032】本発明の第3の構成においては、有機LE D森子の基板として、内部に線状あるいは帯状の機維が 埋め込まれたプラスチック層の一方の面に電極が形成さ れてなるブラスチック基板(第1基板)を用いる。

[0033] 前配第1基板は、プラスチック基板特有の 軽量さという特徴を有しながら、埋め込まれた機維の作 用により熱変形や吸湿変形が小さくなる。また、基板全 体としての機械的強度が高くなる。

板として用いることによりTFTアレイ等を形成する際 【0034】したがって第1基板を有機LED素子の基 にマスク合わせが容易になる。

[0035] また第1基板を有機LED繋子の基板とし て用いることにより、製造工程での基板保持、基板撤送 が容易であり製造歩留まりが向上する。

機雄は、織られたり、機椎同士が直接重なったり直接交 【0036】さらに第1基板においては、埋め込まれた **差した状態ではなく、線状あるいは帯状の繊維同士が互** いに離れた状態でプラスチック層内に埋め込まれる。そ のため従来技術の如くの樹脂を含浸させた繊維布を含む 質層層を基板として用いた場合において基板表面に生じ る機様布の織目や重なり目に起因した凹凸が生じず、ま と面内の屈折率の変化も抑えられ有機LED素子の画質 が劣化が抑えられる。

[0037] 本発明の第4の構成によれば、有機LED **繋子の基板として、内部にカーボン機権という特に熱膨 張係数が小さく、剛性の高い材料からなる機維が埋め込**

まれたプラスチック層の一方の面に電極が形成されてな るプラスチック基板 (第1基板) を用いる。

[0038] 前配第1基板は、プラスチック基板や有の 熱、吸湿による変形が非常に小さいため、熱変形や吸湿 変形が非常に小さくなる。また、基板全体としての機械 軽量さという特徴を有しながら、埋め込まれた機維の 的強度が高くなる。

[0039] したがって第1基板を有機LED寮子の基 板として用いることによりTFTアレイ等を形成する際 にマスク合わせが容易になる。

【0040】また第1基板を有機LED繋子の基板とし て用いることにより、製造工程での基板保持、基板撤送 が容易であり製造歩留まりが向上する。

0041

[発明の実施の形態] 以下、本発明の第1及び第2の構 **成に関わる液晶表示素子の実施の形態についてより詳細**

板である基板10はプラスチック層11の一方の面に導 [0042] 図1に本発明の第1の構成及び第2の構成 に係る液晶表示素子の一例を示す断面図を示す。第1基 電膜からなる電極13が形成されてなる。 ブラスチック 0の電極13が形成された面と対向して第2基板である 透明基板14が配置されている。透明基板14は透明層 15の一方の面に透明電極16が形成されてなる。透明 げ)。これら基板10及び透明基板14との間には液晶 化合物を備える液晶層17が挟持されており、液晶表示 層11の内部には繊維12が埋め込まれている。基板1 お電極13表面には配向膜が形成されている (図示せ 電極18は基板10と対向する面に設けられている。 素子を構成している。

【0043】上配液晶表示素子が透過型液晶表示案子と して用いられる場合には、基板10も透明である必要が あり、基板10を構成するプラスチック層11、内部に 埋め込まれる繊維12及び電極13として透明材料が用

【0044】電極13はTFTアレイを形成していても

【0046】本発明の液晶表示赛子において液晶圏を形 [0045] 上配液晶表示素子が反射型液晶表示素子と 成する液晶化合物に特に制限はなくそれぞれの表示方式 に応じて一般的に用いられる液晶化合物を使用すること して用いられる場合には、基板10に反射層を設ける。 ができる。

【0047】 次に本発明の第1の構成における第1基板 及び第2基板についてさらに説明する。

板においては前配機椎は、機布あるいは不鍛布など、鎌 方の面に電極が形成されてなるものである。 前配第1基 【0048】まず第1の構成における第1基板について 説明する。前記第1基板は内部に線状あるいは帯状の線 維が互いに隔てられて埋め込まれたプラスチック層の一

た状態でプラスチック層内に埋め込まれる。さらに前配 い。これにより基板表面における微小な凹凸の発生を抑 椎が織られたり、機椎同士が直接重なったり交逹した状 **閲ではなく、線状あるいは帯状の繊維同士が互いに離れ** 機椎はプラスチック層の外に露出しないことが窒まし え、画質の劣化を低く抑える。

料としては、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド [0049] 前配第1基板におけるプラスチック層の材 樹脂、アラミド樹脂等を挙げることができ、耐熱性が必 要とされる場合にはポリイミド樹脂、あるいはアラミド 樹脂などを用いることが窒ましい。

[0050] 前記プラスチック層の内部に埋め込まれる 線状の機雄、あるいは長方形、偏平な楕円形等の帯状線 良い。この場合には画案とエッチングされた孔と孔の間 機様は、その断面が、円形、梢円形、あるいは多角形の 椎が挙げられる。箱状の材料をエッチングしたものでも のピッチを合わせることにより光の強過率を大きくとる ことができる。

【0051】前記プラスチック層の内部に埋め込まれる 機構の径又は幅は0.01mm~0.1mmの範囲であ ることが望ましい。 前配繊維の径又は幅が大きすぎると 基板が厚くなりまた表面が不均一になり 平坦性が劣化す る恐れがあり、小さすぎると機械的強度が劣化する恐れ がある。このため基板表面の配線パターンの断線等が発 生する恐れがある。

[0052] 前配機維を構成する材料としては、カーボ ン、ガラス、石英等の線状の前配プラスチック層よりも 熱膨張係数の少ない材料からなることが、第1基板の熱 膨張係数を抑え、熱変形や吸温変形を低く抑える点で窒 ましい。特にカーボン繊維は熟膨張係数が少なく窒まし い。また前配第1基板が透明基板である場合には、ガラ ス、石英等の透明材料を用いる必要がある。

えるものである。第2基板は少なくとも透明基板である ト、ポリエチレンなどの絶像性の透明材料から成る層に 【0053】 次に第1の構成における第2基板について 説明する。第2基板は透明電極が形成された透明層を備 必要があり、ガラス、アクリル系樹脂、ポリカーボネー I TO等の透明電極が形成されたものを挙げることがで きる。また前配透明層は内部に繊維が埋め込まれたもの であってもよい。

[0054] 次に本発明の第2の構成における第1基板 及び第2基板についてさらに説明する。

【0055】まず第2の構成における第1基板について 説明する。前配第1基板は内部にカーボン繊維が埋め込 まれたプラスチック層の一方の面に電極が形成されてな るものである。前配繊維を構成する材料であるカーボン は、熟膨張係数の少ない材料であり、第1基板の熟膨張 係数を抑え、熱変形や吸湿変形を低く抑える。

[0056] 前配第1基板においては前配機樵は、緞布 あるいは不槪布など、機様が織られたり、機様同士が直

€

め込まれることが望ましい。さらに前配繊維はプラスチ ック層の外に露出しないことが望ましい。これにより基 版表面における微小な凹凸の発生を抑え、画質の劣化を 安里なったり 交差した状態ではなく、線状あるいは帯状 の繊維同士が互いに離れた状態でプラスチック層内に埋

要とされる場合にはポリイミド樹脂、あるいはアラミド **みとしては、エポキン樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド** 樹脂、アラミド樹脂等を挙げることができ、耐熱性が必 【0057】前配第1基板におけるプラスチック層の材 樹脂などを用いることが望ましい。

あるいは長方形、偏平な楕円形等の帯状繊維が挙げられ る。箱状の材料をエッチングしたものでも良い。この場 【0058】前配プラスチック層の内部に埋め込まれる カーボン繊維は、その断面がどのようなものであっても 合には画案とエッチングされた孔と孔の間のピッチを合 わせることにより、開口率を犠牲にせずに光の透過率を よいが、円形、楕円形、あるいは多角形の線状の機構、 大きくとることができる。

【0059】前配プラスチック層の内部に埋め込まれる 機雄の径又は幅は0.01mm~0.1mmの範囲であ ることが望ましい。前配機雄の径又は幅が大きすぎると 基板が厚くなりまた表面が不均一になり平坦性が劣化す る恐れがあり、小さすぎると機械的強度が劣化する恐れ がある。このため基板表面の配線パターンの断線等が発 生する恐れがある。

と同様、透明電極が形成された透明層を備えるものであ ガラス、アクリル系樹脂、ポリカーボネート、ポリエチ [0060] 次に第2の構成における第2基板について 説明する。第2基板は、上述した第1の構成の第2基板 レンなどの絶縁性の透明材料から成る層に1T0等の透 る。第4基板は少なくとも透明基板である必要があり、 明亀極が形成されたものを挙げることができる。

において、第1基板と第2基板を構成する材料は、それ [0061]なお、本発明の第1の構成及び第2の構成 ぞれ第1基板と第2基板の平均熱膨張係数が近くなるよ うに選択するのが良い。

要率差)は、画面サイズ、許容できる画繋ずれ長、使用 [0062] 一般的なTFT-LCDにおいて、互いに 対向する基板間の、許容できる熟膨張率の差(許容熱膨 **湿度差により異なり、以下の式で表される。**

ここでdaは許容勲膨張率差、d1は許容画素ずれ長、 [0063] da≤d1/dT/L

範囲10℃かち30℃であるとすると、対向する基板で [0064] 例えば、一方一辺10インチのTFT-L CDでは画素ずれは10μm程度許容できる。使用温度 d T は温度差、L は画面の長辺方向の長さである。

熱膨張係数は−0.2E−6/℃程度であるので、対向 基板である第2 基板は熟膨張係数の小さい石英基板

(0. 55E-6/℃) やチタン珪酸ガラス (-0. 2 E-6/℃)を用いること好ましい。

0, NA35等の熱膨張係数の近いガラスを用いれば良 [0066] また密度の低いカーボン機維を縦横方向に 埋め込んだプラスチック基板を用いた場合、その熱膨張 係数は2~3E-6/C程度であり、例えばホウ珪酸ガ ラス (熟膨張率3~5 E-6/C) の1059やNA4

[0067] 以下、本発明の第3及び第4の構成に関わ る有機LED素子の実施の形態についてより詳細に説明

ラスチック層21の一方の面に形成される電極23はは 層24の面上には有機発光層25が形成されている。有 [0068] 図2に本発明の第3の構成及び第4の構成 に係る有機LED案子の一例を示す断面図を示す。第1 基板である基板20は、プラスチック層21の一方の面 に一対の電極23及び電極26が形成されてなる。 プラ 導電膜からなる陽極電極層である。ついで前配電極23 の面上には正孔輸送图24が形成され、さらに正孔輸送 機発光層25の面上に形成される電極26は導電膜から スチック層21内部に繊維22が埋め込まれている。プ なる陰極電極層である。

【0069】また、有機発光暦25と電極26(陰極電 **返쭨)との間には電子輸送層が追加して散けられること** もあり、あるいは前配正孔輸送層24が省略される場合 **もあるが、何れの場合においても直接、間接に有機発光** 層が腸極電極層と陰極電極層との間に挟まれる構成とな っている。

【0070】 電極23はTFTアレイを形成していても

【0071】さらに電極26上に対向基板や保護層を設 けてもよい。 【0072】本発明の有機LED素子において陽極電極 層、正孔翰送層、有機発光層、陰極電極層、電子輸送層 を形成する材料に特に制限はなく、それぞれの発光方式 こ応じて一般的に用いられる材料を使用することができ 【0073】次に本発明の第3の構成における第1基板 についてさらに説明する。 **₽**

[0074] 第3の構成における第1基板は内部に線状 り交差した状態ではなく、線状あるいは帯状の繊維同士 あるいは帯状の機雄が互いに隔てられて埋め込まれたブ ラスチック層の一方の面に電極が形成されてなるもので **ちる。第1基板においては前配機権は、緞布あるいは不 撒布など、繊維が織られたり、機維同士が直接重なった** が互いに離れた状態でプラスチック層内に埋め込まれ

ことが望ましい。これにより基板表面における微小な凹 る。さらに前記機維はプラスチック層の外に露出しない

方向に埋め込んだプラスチック基板を用いた場合、その

【0065】例えば第1基板としてカーボン概維を縦横

許容できる熱膨張係数の差は4E~6/C以下となる。

凸の発生を抑え、画質の劣化を低く抑える。

料としては、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド 樹脂、アラミド樹脂等を挙げることができ、耐熱性が必 要とされる場合にはポリイミド樹脂、あるいはアラミド 【0075】前配第1基板におけるプラスチック層の材 樹脂などを用いることが望ましい。

椎が挙げられる。箔状の材料をエッチングしたものでも 良い。この場合には画案とエッチングされた孔と孔の間 【0076】前記プラスチック層の内部に埋め込まれる 機様は、その断面が、円形、楕円形、あるいは多角形の 線状の繊維、あるいは長方形、偏平な楕円形等の帯状機 のピッチを合わせることにより光の透過率を大きくとる ことができる。

【0077】前記プラスチック層の内部に埋め込まれる 機雄の径又は幅は0.01mm~0.1mmの範囲であ ることが望ましい。 前配機権の径又は幅が大きすぎると 基板が厚くなりまた表面が不均一になり平坦性が劣化す る恐れがあり、小さすぎると機械的強度が劣化する恐れ がある。このため基板表面の配線パターンの断線等が発 生する恐れがある。

[0078] 前記機維を構成する材料としては、カーボ ン、ガラス、石英等の線状のプラスチック層よりも熟膨 **最係数の少ない材料からなることが、第1基板の熟膨張** 係数を抑え、熱変形や吸湿変形を低く抑える点で望まし い。特にカーボンからなる繊維は熱膨張係数が少なく望 ましい。また前配第1基板が透明基板である場合には、 ガラス、石英等の透明材料を用いる必要がある。

【0079】次に本発明の第4の構成における第1基板 についてさらに説明する。 [0080] 第4の構成における第1基板は内部にカー ボン繊維が埋め込まれたプラスチック層の一方の面に電 極が形成されてなるものである。前配機権を構成する材 第1基板の熱膨張係数を抑え、熱変形や吸湿変形を低く 料であるカーボンは、熟膨張係数の少ない材料であり、

[0081] 前記第1基板においては前記機雄は、緞布 接重なったり交差した状骸ではなく、線状あるいは帯状 め込まれることが望ましい。さらに前配繊維はプラスチ ック層の外に腐出しないことが望ましい。これにより基 板表面における微小な凹凸の発生を抑え、画質の劣化を あるいは不飽布など、繊維が織られたり、繊維同士が直 の繊維同士が互いに離れた状態でプラスチック層内に埋 妬く掛える。

[0082] 第1基板におけるプラスチック層の材料と 脂、アラミド樹脂等を挙げることができ、耐熱性が必要 とされる場合にはポリイミド樹脂、あるいはアラミド樹 しては、エポキン樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹 脂などを用いることが望ましい。

カーボン繊維は、その断面がどのようなものであっても 【0083】前記プラスチック層の内部に埋め込まれる

S

あるいは長方形、偏平な楕円形等の帯状繊維が挙げられ る。箱状の材料をエッチングしたものでも良い。この場 合には画案とエッチングされた孔と孔の間のピッチを合 よいが、円形、楕円形、あるいは多角形の線状の機構 わせることにより光の透過率を大きくとることができ

る恐れがあり、小さすぎると機械的強度が劣化する恐れ 【0084】前配プラスチック層の内部に埋め込まれる がある。このため基板表面の配線パターンの断線等が発 機雄の径又は幅は0.01mm~0.1mmの範囲であ ることが望ましい。前配機維の径又は幅が大きすぎると 基板が厚くなりまた表面が不均一になり平坦性が劣化す 生する恐れがある。

るいはSiO2やSiN×等の無機絶錄膜や、PVA等 の有機絶像膜等が挙げられる。保護膜の形成法はPCV 【0085】なお、第3の構成あるいは第4の構成にお は、ガラス、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ポリカ **ーポネート、ポリエチレンなどの絶録性の透明材料、あ** いて 館極26上に飲けられる対向基板や保護쪔として D, CVD、蒸着、塗布等何でも良い。

[0086] 第1基板と、対向基板あるいは保護層の租 おける第1基板と第2基板の組み合わせの如くその平均 み合わせは、それぞれ第1の構成あるいは第2の格成に 熱膨張係数が近くなるように選択するのが良い。

[0087] 次に上配第1の構成、第2の構成、第3の 構成、第4の構成のそれぞれ第1基板において用いられ る、繊維が埋め込まれたプラスチック層の特に好ましい **影髄の倒について図3、図4、図5を参照して説明す**

図3に示すように餓雑の列からなる쪔が複数쪔、より好 [0088] まず、プラスチック圏の内部には、例えば ましくは3 層以上埋め込まれていることが基板の膨張を **抑える上で望ましい。しかし単層であってもよい。**

の構成、第4の構成の第1基板に係るプラスチック圏の [0089] 図3は上配第1の構成、第2の構成、第3 一例を示す断面図である。 [0090] ブラスチック閥31には1段目の機構32 が複数本プラスチック層31の平坦面とほぼ平行に、方 向をそろえて埋め込まれている。次にプラスチック周3 方向に2段目の機維33が複数本方向をそろえて埋め込 1の平坦面とほぼ平行にかつ1段目の機維32と平行な まれている。更に2段目の繊維33と平行な方向に3段 [0091]また、プラスチック層に繊維の列からなる 層が複数層埋め込まれている場合、例えば図4に示すよ うに各層の繊維の方向が異なっている方が、基板の膨張 目の機構34が複数本方向を揃えて埋め込まれている。

の構成、第4の構成の第1基板に係るプラスチック層の [0092] 図4は上配第1の構成、第2の構成、第3 一例を示す断面図である。

を抑え、強度を向上する上で望ましい。

9

[0093] プラスケック層41には1段目の繊維42 向をそろえて埋め込まれている。次にプラスチック層4 1の平坦面とほぼ平行にかつ1段目の機権42と垂直な 方向に2段目の機権43が複数本方向をそろえて埋め込 まれている。更に垂直な方向に3段目の繊維44が複数 が複数本プラスチック層41の平坦面とほぼ平行に、方 本方向を揃えて埋め込まれている。

てもよいし、図5に示すように、プラスチック層の辺の 【0094】また、プラスチック層の辺の方向と機雄の 方向は図3、図4に示すように平行あるいは垂直であっ 方向と平行あるいは垂直でなくともよい。

[0095] 図5は上記第1の構成、第2の構成、第3 の構成、第4の構成の第1基板に係るプラスチック層の 52の列が複数段にわたって埋め込まれており、基板の **一例を示す平面図である。ブラスチック圏51には繊維** 辺の方向と52方向は約45度を成している。

【0096】 基板上に設けられた配線と、 基板に埋め込 まれる機能は、配線と約45度を成したり、配線と平行 あるいは垂直に配置されることが来その応力分布を均一 にするため留ましい。

[0097] それらの角度以外であると方向により基板 が変形したときの応力分布が異なり配線の応力が異なる ためにTFTが形成される場合、TFT特性の不均一が 発生する。また、応力により基板が変形し、配線の曲が り等が発生する。

【0098】また、機権が埋め込まれたプラスチック層 の接断面は機構が露出するために周辺の部品が傷つきや すい。 特に導電性のカーボン繊維等が露出していると周 る。このため例えば図6、図7に示すように、プラスチ ック層の端面を熱処理により加工して、機維端がプラス チック層の端面より内側に位置せしめ、他の部品との物 理的あるいは電気的接触を防止することができる。同時 辺の部品とショートする可能性があるために問題があ に面取りの効果を出すことが出来る。

の構成、第4の構成の第1基板に係るプラスチック層の [0099] 図6は上記第1の構成、第2の構成、第3 一例を示す断面図である。プラスチック層61には機維 62が埋め込まれており、さらにプラスチック圏61の **岩面を凹状に加工し、繊維62の端がプラスチック層6** 1の婚面より内側に位置せしめている。

の構成、第4の構成の第1基板に係るプラスチック層の [0100] 図7は上配第1の構成、第2の構成、第3 -例を示す断面図である。プラスチック層71には繊維 7.2が埋め込まれており、さらにプラスチック層7.1の 格面を曲面とし機構72の端がプラスチック階71の端 **而より内倒に位配中しめている。**

0101]

[異施例] (奥施例1) まず、図4に示すようなプラス チック 基板を用意した。

20 【01'02】 エポキシ樹脂からなる0. 3 mm厚のプラ

機様42、43、44が埋め込まれており、各機樵の列 からなる層が3層形成されている。すなわち、プラスチ れている。次にプラスチック層41の平坦面とほぼ平行 ック層41には1段目の繊維42が複数本プラスチック 層41の平坦面とほぼ平行に、方向をそろえて埋め込ま 3 が複数本方向をそろえて埋め込まれている。更に垂直 な方向に繊維を方向をそろえて埋め込まれている。この スチック層41には繊維の径が0.05mmのカーボン にかつ 1 段目の繊維 4 2 と垂直な方向に 2 段目の繊維 4 ように繊維42、43、44が埋め込まれたプラスチッ ク層31の熱膨張係数は5m-6/℃であった。

【0103】次に下配に示すように上配プラスチック層 にTFTアレイ等を形成した第1基板、及び第2基板を 作成し、さらにTFT-LCDを組み立てた。

[0104] 図8に実施例1に係るTFT-LCDの断 50図を示す。 【0105】まずカーボン機維81が埋め込まれた対角 10インチのプラスチック層82上に、SiO2をオー パーコートし、MoW等からなるゲート線83を形成

Si層85、n⁺a-Si層86を成膜し、a-Si層 86を形成後に、信号楔87、ソース電極88、ドレイ ン電極89、及び画繁電極90をA1/M o 積層にて形 成した。この上にSiNxのパツペーション膜91を形 成し、画鰲部のSiN×に穴を開けた。この上にポリイ ミドの配向膜(図示せず)を形成してラピング処理をし し、さらに前配ゲート線83にゲート絶縁膜84、a C第1基板を得た。

た。 0. 5mmの石英ガラス92(熟膨張係数5. 5E −7/℃)にITO透明電極93を形成した。前配透明 電極93形成面にポリイミドの配向膜を形成してラピン [0106] 次に以下のようにして第2基板を作成し グ処理をした。

【0107】 次に上配第1基板及び第2基板を用いてT FTーLCDを組み立てた。

記第2基板の透明電極が形成された面とを対向させ、周 [0108] 前配第1基板の電極が形成された面と、 2をエポキン系樹脂で封止した後にTN液晶を注入し 【0109】このように第1基板をTFT-LCDの基 板として用いた場合、第1基板はプラスチック基板であ りながら、TFTアレイ箏を形成する際に変形が1μm **程度でありマスク合わせに問題は無かった。また対向基** FT-LCDは加熱時にも剛性が高く、製造工程中の基 **仮である第2基板としてガラスを用いたが、第1基板と** 熱膨張係数が近く貼り合せが容易であった。 またこのT 板搬送にも問題が無かった。

[0110]また、得られたTFT-LCDの画質は第 1 基板に代えてガラス基板を用いた場合と比較して劣る ことはなかった。すなわちアレイと対向の基板の敷膨張 係数差が小さいために基板が膨れたりへこむことが無く

[0111] 比較例として第1基板に代えてカーボン機 椎の埋め込みのないプラスチック単層の基板を用いて同 4m程度の基板変形があり、マスク合わせができなかっ た。またプラスチック単層の基板を用いた場合では製造 様にTFT-LCDを製造したが、製造工程中に100 工程中に変形のために基板が装置に引っかかった。 ギャップが均一であり画質も均一であった。

(実施例2) まず、図4に示すようなブラスチック層を

[0112] エポキン樹脂からなるの、3mm厚のプラ スチック基板41には機雄の径が0.05mmのカーボ ン様雄42、43、44が埋め込まれており、各機雄の 列からなる層が3層形成されている。すなわち、プラス チック暦41には1段目の機維42が複数本プラスチッ ク層41の平坦面とほぼ平行に、方向をそろえて埋め込 まれている。次にプラスチック層41の平坦面とほぼ平 43が複数本方向をそろえて埋め込まれている。更に垂 のように機雄42、43、44が埋め込まれたプラスチ 行にかつ1段目の機雄42と垂直な方向に2段目の機権 直な方向に機維が方向をそろえて埋め込まれている。 ック層41の熟膨張係数は5E-6/℃であった。

[0113] またプラスチック圏31には光を吸収させ [0114] 上記プラスチック層を用いて以下のように るために黒色顔料粉末も混合している。

しTFTアレイ等を形成した第1 基板を作成し、有機し 【0115】図9に実施例2に係る有機LED案子の平 EDを組み立てた。

ラスチック層102上にSiO2オーバーコートを形成 【0116】まずカーボン繊維101が埋め込まれたブ し、さらにMoW等からなるゲート線103を形成し、

面図を示す。

- S i 層 1 0 6 を形成後に、信号線 1 0 7、ソース電極 108、ドレイン電極109、及び囲<mark>森電</mark>極110をM **o 上にアルミニウムを積層した膜にて形成した。この上** Si層105, n+a-Si周106を成膜し、n+a さらに前配ゲート線103にゲート絶線膜104、a-にSiN×パンペーション膜111を形成した。

磨1,13としてAlq3、電子輸送層として114とし 12としてPBD, TA2, BN, OXDを用い、発光 てポリビニルカルパゾールからなる層を形成し、さらに [0117] さらにこの上に有機LEDの正孔輸送層1 [0118] 次に第1基板のTFTアレイ形成面を、チ タン荘酸ガラス (熱膨張率: -0.2E-6/C) から 上部電極115をAgで形成して第1基板を得た。 なる対向基板116で被覆し、有機LEDを得た。

[0119] このように前配第1基板を有機LED森子 ながら、TFTアレイ箏を形成する際にマスク合わせが の基板として用いることによりプラスチック基板であり 容易であった。また対向基板としてを用いた場合、熟瞭

股係数が近く貼り合せが容易であった。

[0120]またこの有機LEDは発光効率、画質の均 一性が良好であった。

に示したaーSiに限らず、pーSiを用いたものであ っても良い。TFTアレイの構造は本構造に限らず、ゲ [0121] 本発明においては、TFTアレイは実施例 一ト上聞きでも良く、またその他の変形でもよい。 [0122]

し、高い画質を有し、軽量化が可能な液晶表示楽子及び [発明の効果] 以上述べたように、本発明によれば、 ラスチック基板の熱変形及び吸湿による変形を少なく 有機LED案子を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の構成及び第2の構成に係る被 晶表示素子の一例を示す斯面図。

[図2] 本発明の第3の構成及び第4の構成に係る有 【図3】 本発明に係る第1基板のプラスチック圏の一 機LED業子の一例を示す断面図。

[図4] 本発明に係る第1基板のプラスチック層の一 例を示す断面図。

例を示す断面図。

|図5|| 本発明に係る第1基板のプラスチック層の一 列を示す平面図。

【図6】 本発明に係る第1基板のプラスチック層の一

図7】 本発明に係る第1基板のプラスチック層の一 例を示す断面図。

【図8】 実施例1に係るTFT-LCDの断面図。 列を示す断面図。

[図9] 実施例2に係る有機LEDの断面図。 [符号の説明]

10…基板

| 1…プラスチック層

2…概推

13…電極

4…透明基板 15…透明層 6 …透明電極 17…液晶層

20…基板

21…プラスチック層 22…機維

23…電極 (陽極電極層) 24…正孔鹼洪層

2 6 …電極 (陰極電極層) 25…有機発光層

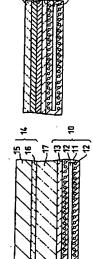
32, 33, 34, 42, 43, 44, 52; 62, 7 31、41、51、61、71…プラスチック圏

8

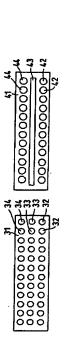
6

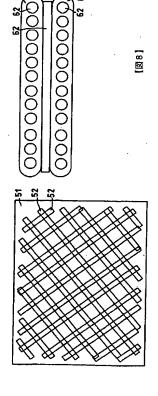
[図2]

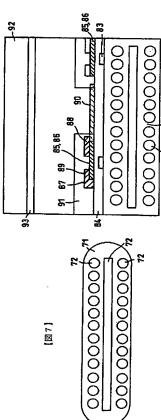
[<u>図</u>]



0000000000 0000000000 [図4] [図3]







0000000000000 000000000000

[6図]

(10)

レロントページの統さ

[886]

[図2]

JD15 JD18 LA01 LA04 3K007 AB13 AB14 AB18 BB07 CA00 CA05 CB01 DA00 DB03 EB00 Fターム(参考) 2H090 JA07 JA16 JB03 JC07 JD14

FA01 5C094 AA02 AA33 AA38 AA43 AA60 BA03 BA27 BA43 DA09 EA05 EB01 EB02 FB01

THIS PAGE BLANK (USPTO)